

圖 11-20 NAND 快閃記憶體訊號的寫入與擦拭。

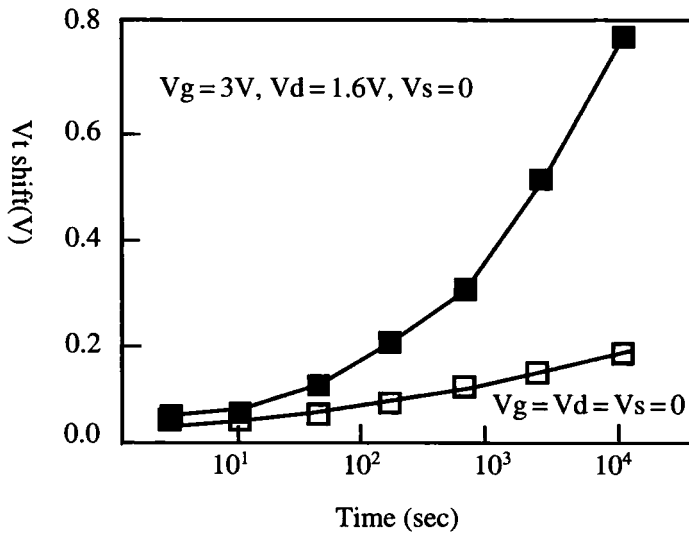


圖 11-21 由於擦寫容忍度 (endurance) 測試造成的臨界電壓飄移。

在資料讀取方面，快閃記憶體利用電荷儲存於浮動閘內而改變元件的臨界電壓，當字元線選出特定位址，不同的臨界電壓造成不同的汲極電流，因而分別出訊號的 0 與 1，如圖 11-22。